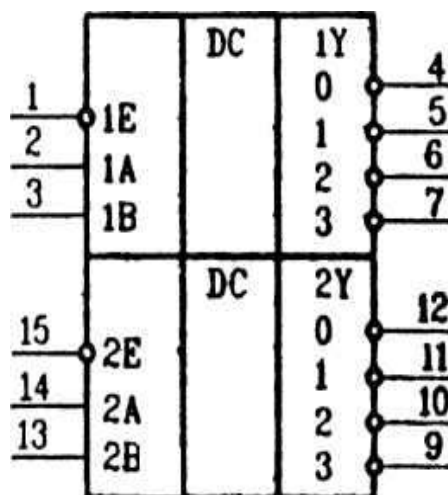


# КР1533ИД14, КФ1533ИД14, ЭКФ1533ИД14

Микросхемы представляют собой сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2 на 4 с индивидуальным входом выбора и разрешения. Пластмассовый корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г, 4307.16-А.

Назначение выводов: 1, 15 - входы разрешения  $\overline{1E}$ ,  $\overline{2E}$ ; 2, 3, 13, 14 - информационные входы 1А, 1В, 2А, 2В; 4...7, 9...12 - выходы 1Y0...1Y3, 2Y3...2Y0; 8 - общий; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИД14, КФ1533ИД14, ЭКФ1533ИД14

## Таблица истинности

Вход			Выход			
$\overline{E}$	В	А	$\overline{Y0}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y3}$
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания .....5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 4 \text{ мА}$  ..... ≤ 0,4 В

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 8 \text{ мА}$  ..... ≤ 0,5 В

Выходное напряжение высокого уровня при  $I_{\text{вых}}^1 = -0,4 \text{ мА}$  ..... ≥ 2,5 В

Прямое падение напряжения на антизвонном диоде ..... ≤ | -1,5 | В

Входной ток низкого уровня .....	$\leq  -100 $ мкА
Входной ток высокого уровня .....	$\leq 20$ мкА
Ток потребления при $U_n = 5,5$ В .....	$\leq 13$ мА
Время задержки распространения при включении:	
- по входу $\bar{E}$ .....	$\leq 15$ нс
- по входам А или В .....	$\leq 14$ нс
Время задержки распространения при выключении .....	$\leq 14$ нс

### Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания .....	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня .....	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня .....	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход .....	5,5 В
Температура окружающей среды .....	-10...+70 °С

### Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не

более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В  $\pm 10\%$ , к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.